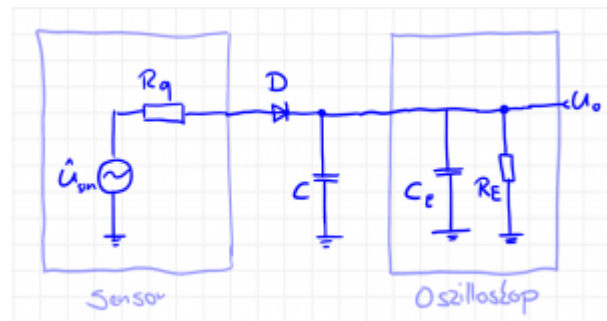


Aufgabe 2.1.1 Diode bei höheren Frequenzen



In Ihrer Firma „HHN Mechatronics & Robotics“ haben Sie einen Eintaktgleichrichter aufgebaut, um ein sinusförmiges Messsignal von ($f=200\text{kHz}$, Amplitude $\hat{U} = 5,0\text{V}$, Ausgangswiderstand des Sensors $R_q = 10\text{k}\Omega$) gleichzurichten. Dazu haben Sie eine einfacher Schaltung mit der „Si-Gleichrichterdiode“ $D=1\text{N}5400$ und einen Glättungskondensator mit $C=10\text{pF}$ aufgebaut. Als Messgerät nutzten Sie ein Oszilloskop (Rigol DS1000E). Die Schaltung ist in nebenstehender Skizze gezeichnet.

Ihr Kollege hat Sie bereits darauf hingewiesen, dass bei hohen Frequenzen manche Dioden ein Problem mit dem Gleichrichten bekommen. Das haben Sie beim Durchmessen des Aufbaus und Blick auf das Oszilloskop auch gemerkt...

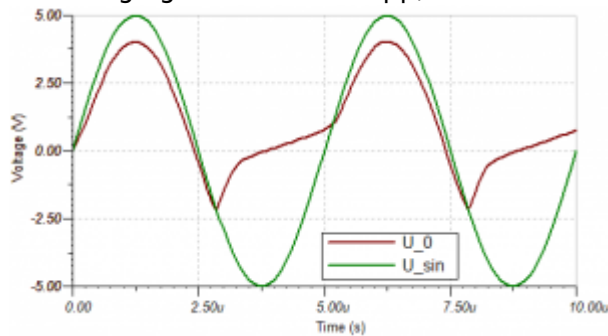
Schreiben Sie den erwarteten Signalverlauf vor der jeweiligen Simulation auf. Beachten Sie, dass Sie in der Simulation ein eingeschwungenes System betrachten müssen!

1. Suchen Sie in der [Anleitung des Oszilloskops](#) die Werte der Eingangsimpedanz, welche in der Schaltung für den Eingangswiderstand R_E und die Eingangskapazität C_E benötigt werden.

Bilden Sie die Schaltung in mit den Angaben von oben TINA TI nach (**Schaltung 1**). Dabei ist - wie in der Skizze dargestellt - die Eingangsimpedanz des Oszilloskops zu berücksichtigen.

Simulieren Sie die Schaltung 1 mit dem angegebenen Signal. Beschreiben Sie kurz den erwarteten und gemessenen Signalverlauf.

7. Ihr Kollege gibt Ihnen den Tipp, dass der Verlauf (siehe Diagramm rechts) typisch sei für

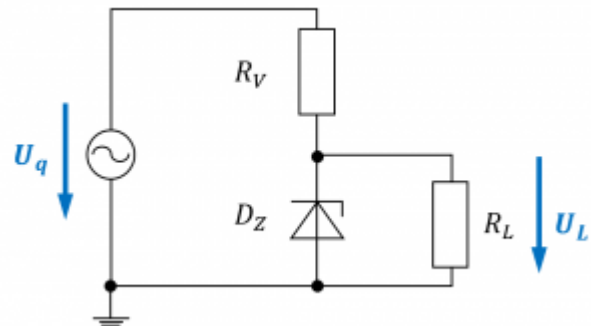


1. einen zu großen Sperrverzug / eine zu große Sperrverzugszeit (reverse recovery time t_{rr}). Diese ist in Tina über die Transitzeit (Transit Time TT) nachgebildet
 2. eine zu große Sperrschichtkapazität (junction capacity C_j oder diode capacity C_{D}).
8. Diese Werte sind in Tina TI über folgendes Vorgehen veränderbar: Doppelklick auf die Diode » Klick auf ... bei Type » Suchen der genannten Größen.
Sie wollen nun analysieren wie jeweils der Sperrverzug und die Sperrschichtkapazität auf den Spannungsverlauf (bei Schaltung 4) bewirkt.
Simulieren und beschreiben Sie dafür den Spannungsverlauf wenn
1. einerseits den Sperrverzug auf $0s$ zurückgesetzt oder
 2. andererseits die Sperrschichtkapazität auf $0F$ zurückgesetzt wird.

9. Wählen Sie statt der Diode $D=1N5400$ die Diode $D=1N4148$ und simulieren Sie nochmals die Schaltung 3 und Schaltung 1.
Wie verhält sich nun der Spannungsverlauf und warum?

4. Vergleichen Sie kurz die unterschiedlichen Ergebnisse unter Berücksichtigung der [E12 Reihe](#).

Aufgabe 2.1.3 Z-Diode als Spannungsreferenz



Eine Z-Diode ermöglicht in einer Spannungsreferenz-Schaltung, dass - trotz einer schwankenden Eingangsspannung - eine Ausgangsspannung relativ konstant gehalten werden kann. Dazu kann im einfachsten Fall eine Schaltung wie rechts abgebildet verwendet werden. Für die Aufgabe sollen folgenden Größen genutzt werden:

- Quellenspannung $U_q = 7,0 \dots 13,0 \text{ V}$ (z.B. über sinusförmige Eingangsspannung mit $f = 50 \text{ Hz}$),
- Vorwiderstand $R_V = 1,0 \text{ k}\Omega$
- Lastwiderstand $R_L = 10 \text{ k}\Omega$
- Z-Diode D_Z als $BZX84C6V2$ ($U_Z = 6,2 \text{ V}$)

Von einer idealen (Z-)Diode würde man annehmen, dass die Durchbruchspannung U_Z bei allen Sperrströmen I_S gehalten werden kann.

Für die reale Diode soll dies überprüft werden.

1. Bilden Sie die Schaltung in Tina TI nach und fügen Sie ein Bild der Schaltung ein.
2. Vergleichen Sie den Verlauf von U_L zu U_q . Messen Sie dabei insbesondere Maximal- und Minimalwert von U_L .

3. Ändern Sie den Lastwiderstand auf $R_L = 1,0k\Omega$ und führen Sie den gleichen Vergleich von U_L zu U_q nochmals durch.

4. Wie lässt sich der Unterschied erklären?

Aufgabe 2.1.4 Berechnung des differentiellen Widerstands einer Diode

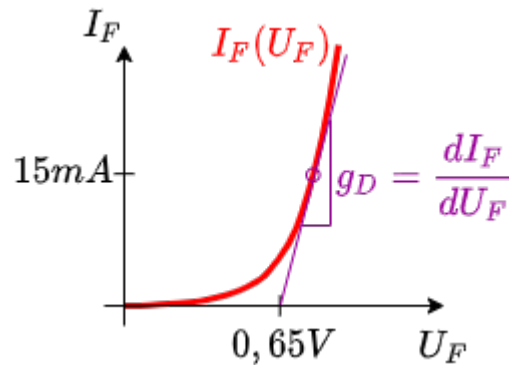


Abb. 1: Idealisierte Diode

Der differentielle Widerstand r_D einer Diode wurde bereits im Kapitel beschrieben. Dieser ist notwendig, wenn eine Diode über ein vereinfachtes Dioden-Modell (Spannungsquelle + Widerstand + ggf. ideale Diode) nachgebildet werden soll. In [Abbildung 1](#) sehen Sie den differentiellen Leitwert $g_D = \frac{1}{r_D}$ als lokale Steigung am gewünschten Arbeitspunkt. Berechnen Sie den differentiellen Widerstand r_D bei einem Durchlassstrom $I_D = 15\text{ mA}$ für Raumtemperatur ($T = 293\text{ K}$) und $m = 1$ aus der Shockley-Gleichung: $I_F = I_S(T) \cdot (e^{\frac{U_F}{m \cdot U_T}} - 1)$ mit $U_T = \frac{k_B \cdot T}{e}$. Berechnen Sie dazu zunächst die allgemeine Formel für den differentiellen Widerstand r_D .

Schritte:

1. Vereinfachen Sie als erstes die Shockley-Gleichung für $U_F \gg U_T$

2. Ermitteln Sie eine Formel für $\frac{dI_F}{dU_F}$.

3. Ersetzen Sie einen Teil des Ergebnisses wiederum durch I_F und drehen Sie den Bruch für die Berechnung des differentiellen Widerstands um $r_D = \frac{d U_F}{d I_F}$.
- Als Ergebnis sollte nun $r_D = \frac{d U_F}{d I_F} = \frac{m \cdot U_T}{I_F}$ vorliegen

4. Rechnen Sie r_D aus.

From:
<https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/> - **Mexle Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/uebungsblatt3

Last update: **2020/09/29 10:50**

